

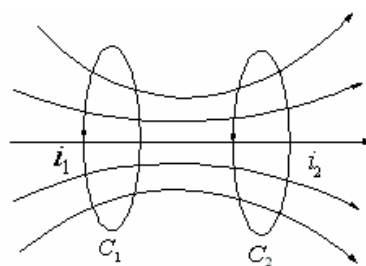
第二十五讲

复习:

- 材料的磁性: 抗磁性, 顺磁性, 铁磁性
- 自感, 互感:

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_{22} + \varepsilon_{21} = -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{12} = -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$



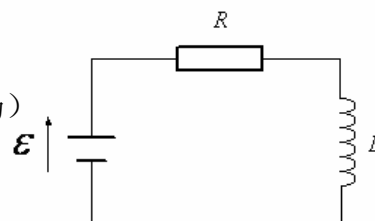
L : 自感系数; M : 互感系数; 计算应结合法拉第定律

三、 LR 电路

前面学习过 RC 电路, 从建立电势差的角度来看, 结论是 C 总是比 R 的响应慢半拍。现在我们要研究 LR 串联电路, 如右图所示。解决电路问题要用到 Kirchhoff 的两个定律:

Kirchhoff 定律 1 \rightarrow 电流 i 处处相同 (电荷守恒)

Kirchhoff 定律 2 \rightarrow 电势差环路为 0 (静电场为保守场)



1. 电流建立过程

将电阻、电感与电动势相连, 根据 Kirchhoff 定律 2, 得:

$V_\varepsilon + V_R + V_L = 0$, 沿着电流的方向分别计算电源、电阻、电感上的电势差,

$$\varepsilon - iR - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = iR + L \frac{di}{dt}$$

$$\frac{\varepsilon}{L} - \frac{R}{L}i = \frac{di}{dt}, \text{ 积分可得:}$$

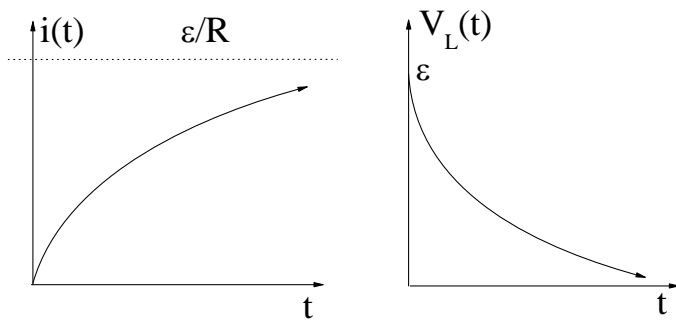
$$\int_0^i \frac{di'}{\varepsilon/L - R/L \cdot i'} = \int_0^t dt' \Rightarrow -\frac{L}{R} \ln \left(\frac{R}{L} \cdot i' - \frac{\varepsilon}{L} \right) \Big|_0^i = t$$

$$\ln \left(\frac{\varepsilon/L - R/L \cdot i}{\varepsilon/L} \right) = -\frac{Rt}{L}, \text{ 得 } \frac{\varepsilon}{L} - \frac{R}{L}i(t) = \frac{\varepsilon}{L} e^{-\frac{R}{L}t}, \text{ 即}$$

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \left(1 - e^{-t/\tau_L} \right) \text{ 其中: } \frac{L}{R} = \tau_L \text{ 为驰豫时间 (} L \text{ 大则电流不易变化, 因而 } \tau \text{ 长。作为对比: } \tau_c = RC \text{)。}$$

落在电阻及电感上的电势差分别为:

$$|V_R| = i(t)R, \quad |V_L| = \left| -L \frac{di}{dt} \right| = \varepsilon e^{-t/\tau_L}$$



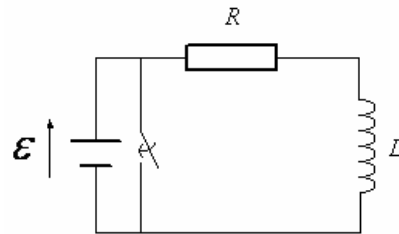
物理图像象：当电源接通时，电流的变化立刻被电感器感知到，因此电感上产生了最大的电势差（全部电动势）。电流逐渐建立后，稳恒的过程中电压逐渐转移到电阻上，最后直流极限电感上没有电压。

2. 电流消失过程（将电池短路）

$$V_R + V_L = 0$$

$$iR + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$iR = -L \frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{di}{i} = -\frac{R}{L} \cdot dt$$

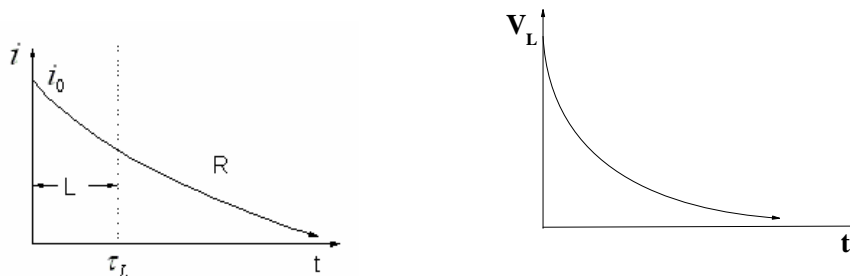


积分可得

$$\ln \left(\frac{i(t)}{i_0} \right) = -\frac{t}{\tau_L} \quad \left(\tau_L = \frac{L}{R} \right), \quad \text{则电流及电感上的电势差分别为}$$

$$i(t) = i_0 e^{-t/\tau_L} = \frac{\varepsilon}{R} \cdot e^{-t/\tau_L}$$

$$V_L = -L \frac{di}{dt} = L \cdot \frac{\varepsilon}{R} \cdot \frac{R}{L} \cdot e^{-t/\tau_L} = \varepsilon e^{-t/\tau_L}$$



结论：综合两例发现 L 对 i 变化的响应总是快过 R (R 对电流变化的响应是即时的)。当电流变化来时 L 先，R 中，C 后。

四、磁场能

与电容相似，电感可以贮存磁能。检查一个 LR 串联电路看电感内部的 \vec{B} 场是如何建立的。电动势的输出功率

$$P = \varepsilon i \quad (\text{单位时间电源对外界做功})$$

单位时间以热能形式耗散在 R 上

$$\frac{dQ}{dt} = i^2 R$$

剩余的用以建立磁场能

$$(\varepsilon i - i^2 R) = \frac{dU_B}{dt} \Rightarrow Li \frac{di}{dt} = \frac{dU_B}{dt}$$

电路中，电流最后稳定时的静磁能

$$U_B(i) = \frac{1}{2} Li^2$$

思考: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \leftarrow$ 磁场对运动电荷(电流)产生作用力。但是, 当 \vec{B} 稳恒时, $\vec{F} \perp \vec{v}(\vec{j})$ 磁场不对电流做功 $\vec{F} \cdot \vec{j} = 0$, 那么磁场能如何与电流交换能量建立起来的?

五: 磁能密度

长螺线管的自感系数为: $L = \mu_0 \mu_r n^2 \cdot \Omega$

则体系的总磁能为: $U_B = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r n^2 i^2 \cdot \Omega$, 则

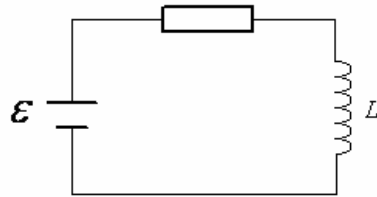
可定义磁能密度: $u_B = \frac{U_B}{\Omega} = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r n^2 i^2$

注意到: $B = \mu_0 \mu_r ni$, 则, $u_B = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0 \mu_r}$

事实上此式严格成立, 而且成立的范围更广, 对非均匀磁场及随时间变化的磁场,

均有: $u_B(\vec{r}) = \frac{1}{2} \frac{|\vec{B}(\vec{r})|^2}{\mu_0 \mu_r}$

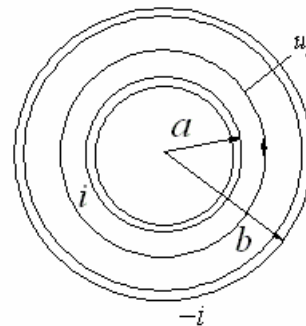
将两种磁场能的表达式做一对比



$$U_B = \frac{1}{2} Li^2 \qquad u_B(\vec{r}) = \frac{1}{2} \frac{|\vec{B}(\vec{r})|^2}{\mu_0 \mu_r}$$

磁能被 i 带有 磁能以场能的形式存在
不妨与电场能（电容能）做一个对比，可以发现同样的结论。

例：同轴电缆 内导体：半径 a 的导体柱壳
 外导体：半径 b 的导体柱壳
 内导体：电流 i 均匀分布在壳上
 外导体：电流 i 均匀分布在壳上
 电流从内导体流出，从外导体流回来，形成回路。



求：a) 单位长度内的磁场能
 b) 单位长度的自感

解：a) 求 \vec{B} ：

$$H(r) = \frac{i}{2\pi r} \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 \mu_r i}{2\pi r} \quad (r \in [a, b]); \text{ 其他区域为 } 0.$$

$$\text{磁场能密度为：} \mu_B(\vec{r}) = \frac{1}{2\mu_0 \mu_r} |\vec{B}(\vec{r})|^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r \frac{i^2}{4\pi^2 r^2} = \frac{\mu_0 \mu_r i^2}{8\pi^2 r^2}$$

总磁场能（总长度为 h ）：

$$U_B = h \cdot \int \mu_B(\vec{r}) \cdot 2\pi r dr = h \cdot \int_a^b \frac{\mu_0 \mu_r i^2}{4\pi r} dr = \frac{\mu_0 \mu_r i^2}{4\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \cdot h$$

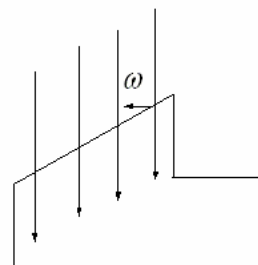
$$\text{b) } U_B = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) i^2 \cdot h$$

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \cdot h \qquad \text{单位长度的电感为 } L = \frac{\mu_0 \mu_r}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

思考题：

- (1) 利用电感的定义来计算此体系的电感系数，是否得到同样的结果？
- (2) $b \rightarrow \infty$ 时此结果应回到一个半径为 a 的单导线的情况。但结果发散，你觉得奇怪么？
- (3) 目前的定义及计算只对细导线成立。若导线有一定的截面积，因此导线内部的磁通量不能忽略，应如何计算电感？
- (4) 目前的定义及计算假设电流沿导线均匀，所以可以用一个参量 i 来代表。若导线上因为某种原因必须考虑电流非均匀，此时如何定义及计算 L ？

第 37 章：交流电路



(1) 定义

直流 → 电流方向不随时间变化

交流 → 电流方向随时间变化

(如右图所以，在磁场中的旋转线圈即产生一个交流电动势，接上外加负载，即有交流电流)。

交流电的随时间变化的方式很多，最简单为简谐交流电：

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(\omega t) \quad \leftarrow \text{可以由线圈以恒定的角频率切割磁力线得到。}$$

根据 Fourier 变换，任意的随时间变化的函数可展开

$$F(t) = \sum_{\omega} \varepsilon_{\omega} \sin(\omega t)$$

因此，只要单频的情况明白了，所有的都明白了。

单频的外电动势： $\varepsilon = \varepsilon_m \sin \omega t$ 即是一个受迫振动源（类似力学中的受迫振

子）。瞬态过去后，回路中产生的电流一定为： $i(t) = i_m \sin(\omega t - \phi)$ ← 受

迫振动的基本概念，即振动的方式一定于振动源 ω 一定相同。但振幅与相位 i_m, ϕ 未知，是我们本章的核心内容。在解决这个问题之前，我们首先分别研究各个基本元件的电压与电流之间的关系。

(2) 基本元件的电压差与电流之间的关系

为统一起见，取电势差为 $\Delta V = V_a - V_b$ （与我们前期的定义略有不同）。

a) 电阻 R

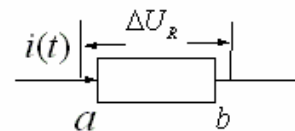
直流时 $Ri = \Delta V = V_a - V_b$

交流时（ ω 不太大时欧姆定律成立）仍成立：

$$Ri(t) = \Delta V(t)$$

$$\Delta V_R(t) = i_m R \sin(\omega t - \phi)$$

结论： ΔV_R 与 $i(t)$ 同位相，与 ω 无关



b) 电感 L

基本方程： $\varepsilon = -L \frac{di}{dt} = V_b - V_a$ ← 理想无内阻



$$\Delta V(t) = V_a - V_b = L \frac{di}{dt} = L\omega \cos(\omega t - \phi) = L\omega \sin(\omega t - \phi + \frac{\pi}{2})$$

$$\Delta V_L(t) = X_L \sin(\omega t - \phi + \frac{\pi}{2})$$

$X_L = L\omega$ 即定义为感抗（与电阻同量纲）。其与频率成正比，因此，高频电流不

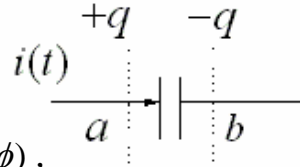
易通过 L 。另外， ΔV_L 比 $i(t)$ （或是 $V_R(t)$ ）快 $\frac{\pi}{2}$ 相位。

c) 电容 C

$$V_a - V_b = \frac{q(t)}{C}$$

看起来似乎没电流，但交流电可以“有效”通过 C

因 $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ ，对简谐变化的电流， $i(t) = i_m \sin(\omega t - \phi)$ ，



可知， $q(t) = -\frac{i_m}{\omega} \cos(\omega t - \phi)$ （成立条件：最初的瞬态过去之后，稳定后的结果）

$$\text{故： } \Delta V_C = \frac{q(t)}{C} = -\frac{1}{\omega C} i_m \cos(\omega t - \phi) = \frac{1}{\omega C} i_m \sin(\omega t - \phi - \frac{\pi}{2})$$

可定义 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 为容抗，与电阻、感抗同量纲且物理作用一致。容抗与频率成反比， $\omega \rightarrow 0$ 时 $x_C \rightarrow \infty$ ，因此低频不能通过（直流电的确不能通过电容）。另

外： C 上电压的相位比电流（或是电阻上的电压相位）晚 $\frac{\pi}{2}$ 。

总结：与前期的结论一致， L 的变化快过 R 快过 C 。

将 $V-i$ 关系写成统一的形式：

$$\Delta V_{R,L,C}(t) = X_{R,L,C} i_m \sin(\omega t - \phi + \Delta\phi_{R,L,C})$$

$X_R = R$	$X_L = L\omega$	$X_C = \frac{1}{C\omega}$
$\Delta\phi_R = 0$	$\Delta\phi_L = \frac{\pi}{2}$	$\Delta\phi_C = -\frac{\pi}{2}$

与频率无关，即时	阻高频，通低频，快半拍	阻低频，通高频，慢半拍
----------	-------------	-------------

习题：P842, Problems, 5, 9, 10
P840, Exercices, 30, 32